# Факультет безопасности информационных технологий Университет ИТМО



Группа	ФИЗ-2 Э БИТ 1.1.1	_ К работе допущены	
Студенты	Бардышев Артём		
	Машин Егор	Работа выполнена	
	Суханкулиев Мухаммет		
	Шегай Станислав		
Преподава	тель	Отчет принят	

# Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.06

### Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков

## 1. Цель работы.

- 1. Определение значений электрического смещения насыщения  $D_s$ , остаточной поляризации  $P_r$ , коэрцитивной силы  $E_c$  для пре дельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика.
- 2. Расчет диэлектрических потерь за цикл переполяризации сегнетоэлектрика.
- 3. Получение зависимостей смещения D и диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля E.
- 4. Определение значений начальной и максимальной диэлектрической проницаемости

#### 2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- 1. Изучить предельную петлю гистерезиса.
- 2. Измерить зависимость смещения D от напряженности E.

#### 3. Объект исследования.

Сегнетоэлектрический конденсатор (вариконд) ВК2-4.

## 4. Метод экспериментального исследования.

Экспериментальный метод.

### 5. Рабочие формулы и исходные данные.

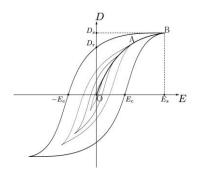


Рисунок 1 — Петля гистерезиса сегнетоэлектрика

Санкт-Петербург 2024 г.

#### Формулы:

1. Модуль вектора электрической индукции  $\vec{D}$  равен поверх ностной плотности заряда на обкладках:

$$D = \frac{C_1}{S} \cdot U_{C_1}$$

2. Напряженность электрического поля Е в сегнетоэлектрике:

$$E = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{U_{R_1}}{d}$$

3. Тангенс угла диэлектрических потерь в сегнетоэлектриках:

$$tg\delta=rac{1}{\pi}rac{\oint D_r dE_c}{D_s E_s}$$
, где  $D_s$  и  $E_s$  в дел.

4. Диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрика:

$$\varepsilon = \frac{D}{\varepsilon_0 E}$$

5. 
$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\mathrm{K}\pi^2}{\mathrm{H} \cdot \mathrm{M}^2}$$

6. Остаточная поляризация:

$$D_r = P_r + \varepsilon_0 E_c \Longrightarrow P_r = D_r - \varepsilon_0 E_c$$

Исходные данные:

$$R_1 = 47 \ \mbox{к0м} \pm 10\%; R_2 = 470 \ \mbox{к0м} \pm 10\%;$$
  $C_1 = 1 \ \mbox{мк} \Phi \pm 10\%; C_2 = 0.01 \ \mbox{мк} \Phi \pm 10\%;$ 

Площадь пластин конденсатора:  $S = 500 \text{ мм}^2 \pm 10\%$ ;

Толщина сегнетоэлектрика:  $d = 0.5 \text{ мм} \pm 10\%$ .

## 6. Измерительные приборы.

№ n/n	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон		
1	C3-PM02	Стенд	0–20 B		
2	ИСХ1	Осциллограф	0–20 B		

## 7. Схема установки.

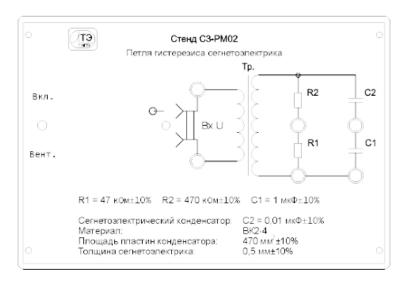


Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема установки

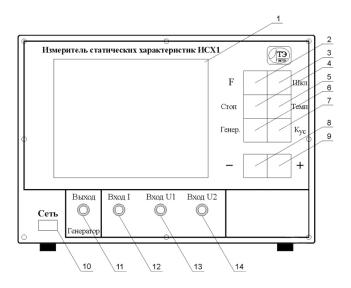


Рисунок 3 – Общий вид панели лицевой панели «ИСХ-1»

- 1. графический дисплей;
- 2. кнопка выбора режима работы «F»;
- 3. кнопка выбора шкалы «Шкл.»;
- 4. кнопка запоминания оцифрованного сигнала «Стоп»;
- 5. кнопка выбора температурного режима «Темп»;
- 6. кнопка управления генератором «Генер.»;
- 7. кнопка выбора коэффициента отклонения «Кус»;
- 8. кнопка уменьшения выбранной величины «-»;
- 9. кнопка увеличения выбранной величины «+»;
- 10. кнопка выключателя «Сеть»;
- 11. выход генератора;
- 12. вход тока І;
- 13. вход напряжения U1;
- 14. вход напряжения U2;

## 8. Результаты прямых измерений и их обработки.

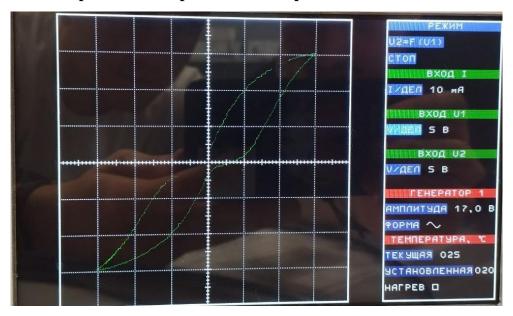


Рисунок 4 – Предельная петля гистерезиса (на фоне мы :D)

PS На рисунке показана «неправильная» петля. Данные с нашей правильной петли:

$$D_s = 2.6$$
 дел;  $E_s = 3$  дел;  $D_r = 0.8$  дел;  $E_c = 0.6$  дел.

Примерная площадь петли гистерезиса (по сделанной фотографии):

$$S \approx 7.6 \, \text{дел}^2$$

Согласно размерности 1 дел = 5 В. Тогда:

$$U_{C_1} = 2.6 \cdot 5 \text{ B} = 13 \text{ B}$$

$$U_{R_1} = 3 \cdot 5 \text{ B} = 15 \text{ B}$$

Вычислим  $E_c$ ,  $D_s$ ,  $P_r$  при помощи формул (1, 2):

$$D_s = \frac{0.000001 \,\Phi}{0.0005 \,\mathrm{m}^2} \cdot 13 \,\mathrm{B} = \mathbf{0.026} \,\frac{\mathrm{K}\pi}{\mathrm{m}^2}$$

$$E_c = \frac{47000 + 470000 \text{ Om}}{47000 \text{ Om}} \cdot \frac{15 \text{ B}}{0.0005 \text{ m}} = \mathbf{330000} \frac{\text{B}}{\text{m}}$$

Таблица 1 – Зависимость диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика от напряженности электрического поля

	Физические величины							
No	U, B	$K_{\chi}$ ,	$K_y$ ,	Χ,	Υ,	Ε,	D,	ε
		В/дел	В/дел	дел	дел	В/м	Кл/м2	
1.	17	5	5	3	2,6	330000	0,026	8902,59
2.	15	5	5	2,5	2,4	275000	0,024	9861,33
3.	13	5	5	2,2	2,2	242000	0,022	10272,21
4.	11	5	5	2	2	220000	0,02	10272,21
5.	9	5	5	1,6	1,6	176000	0,016	10272,21
6.	7	5	5	1,2	1,1	132000	0,011	9416,20
7.	5	5	5	0,9	0,6	99000	0,006	6848,14
8.	4,4	5	5	0,8	0,5	88000	0,005	6420,13
9.	3,8	5	5	0,7	0,3	77000	0,003	4402,38

10.	3,2	5	5	0,6	0,3	66000	0,003	5136,11
11.	2,6	5	5	0,5	0,2	55000	0,002	4108,89
12.	2	5	5	0,4	0,1	44000	0,001	2568,05
13.	1,4	5	5	0,25	0,05	27500	0,0005	2054,44
14.	0,8	5	5	0,15	0,02	16500	0,0002	1369,63
15.	0,2	5	5	0,03	0,01	3300	0,0001	3424,07

Значения E, D,  $\varepsilon$  вычислили по формулам 1, 2, 4.

## 9. Расчет результатов косвенных измерений.

Чтобы найти  $P_r$  и  $tg\delta$  нужно найти посчитать  $D_r$ , при этом  $U_{\mathcal{C}_1}=0.8\cdot 5~\mathrm{B}=4~\mathrm{B}$ 

Так же  $U_{R_1} = 0.6 \cdot 5 \text{ B} = 3 \text{ B}$  (понадобится позже).

$$D_r = \frac{0.000001 \,\Phi}{0.0005 \,\mathrm{m}^2} \cdot 4 \,\mathrm{B} = 0.008 \,\frac{\mathrm{K}\pi}{\mathrm{m}^2}$$

Из формулы (6) имеем:

$$P_r = 0.008 \frac{\text{K}\pi}{\text{M}^2} - 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{K}\pi^2}{\text{H} \cdot \text{M}^2} \cdot 330000 \frac{\text{B}}{\text{M}} \approx \mathbf{0.008} \frac{\text{K}\pi}{\text{M}^2}$$

Так же из (3) находим:

$$tg\delta = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{0.008 \frac{\text{K}\pi}{\text{M}^2} \cdot 330000 \frac{\text{B}}{\text{M}}}{2.6 \cdot 3} \approx 107.74$$

## 10. Расчет погрешностей измерений

$$\Delta C_1 = 0.1 \cdot C_1$$
$$\Delta U_{C_1} = 0.5$$

$$\Delta S = 0.1 \cdot S$$

$$\Delta D_S = \sqrt{\left(\left(\frac{1}{S} \cdot U_{C_1}\right) \cdot \Delta C_1\right)^2 + \left(\frac{C_1}{S} \cdot \Delta U_{C_1}\right)^2 + \left(\left(-\frac{C_1}{S^2} \cdot U_{C_1}\right) \cdot \Delta S\right)^2}$$

 $\Delta D_{s}$ 

$$=\sqrt{\left(\left(\frac{1}{0.0005}\cdot 13\right)\cdot 0.000001\cdot 0.1\right)^2+\left(\frac{0.000001}{0.0005}\cdot 0.5\right)^2+\left(\left(-\frac{0.000001}{0.0005^2}\cdot 13\right)\cdot 0.0005\cdot 0.1\right)^2}$$

 $\approx 0.004$ 

 $\Delta E_c$ 

$$= \sqrt{\left((\frac{R_2}{R_1^2} \cdot \frac{U_{R_1}}{d}) \cdot \Delta R_1\right)^2 + \left((\frac{1}{R_1} \cdot \frac{U_{R_1}}{d}) \cdot \Delta R_2\right)^2 + \left((\frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{d}) \cdot \Delta U_{R_1}\right)^2 + \left((-\frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{U_{R_1}}{d^2}) \cdot \Delta d\right)^2}$$

$$\Delta E_{c}$$

$$=\sqrt{\left(\frac{470000}{47000^2}\cdot\frac{3}{0.0005}\right)\cdot 4700\right)^2+\left(\frac{1}{47000}\cdot\frac{3}{0.0005}\right)\cdot 47000\right)^2+\left(\frac{47000+470000}{47000}\cdot\frac{1}{0.0005}\right)\cdot 0.3\right)^2+\left((\frac{47000+470000}{47000}\frac{3}{0.0005^2})\cdot 0.00005\right)^2+\left(\frac{470000}{47000}\cdot\frac{3}{0.0005}\right)\cdot 0.3$$

 $\approx 12614.28$ 

 $\Delta D_r$ 

$$= \sqrt{\left(\left(\frac{1}{0.0005} \cdot 4\right) \cdot 0.000001 \cdot 0.1\right)^{2} + \left(\frac{0.000001}{0.0005} \cdot 0.5\right)^{2} + \left(\left(-\frac{0.000001}{0.0005^{2}} \cdot 4\right) \cdot 0.0005 \cdot 0.1\right)^{2}}$$

$$\approx 0.0015$$

$$\Delta P_r = \sqrt{((1)\Delta D_r)^2 + ((\varepsilon_0) \cdot \Delta E)^2 + ((E) \cdot \Delta \varepsilon_0)^2}$$

$$\Delta P_r = \sqrt{(0.0015)^2 + ((8.85 \cdot 10^{-12}) \cdot 12614.28)^2 + ((330000) \cdot 0.000000005 \cdot 10^{-12})^2}$$

$$\approx \mathbf{0.0015}$$

## 11. Графики

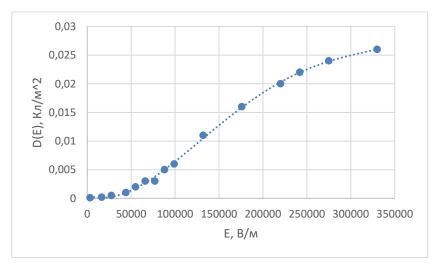


Рисунок 5 — График зависимости D = D(E)

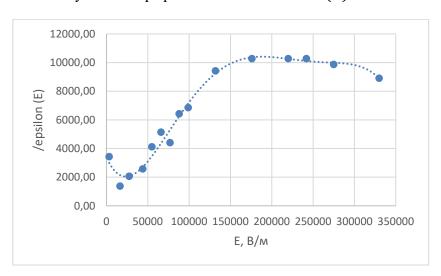


Рисунок 6 – График зависимости  $\varepsilon = \varepsilon(E)$ 

## 12. Окончательные результаты.

 $D_{s} \approx 0.026 \pm 0.004 \, \frac{\mathrm{K_{J}}}{\mathrm{M}^{2}} -$  Электрическая индукция в состоянии насыщения (электрическое смещение напряжения);

$$E_c \approx 330000 \pm 12614.28 \frac{\text{B}}{\text{M}} - \text{Коэрцитивное поле;}$$

$$P_r \approx 0.008 \pm 0.0015 \, rac{{
m K}_{
m M}}{{
m M}^2} -$$
 Остаточная поляризация;

 $tg\delta \approx 107.74$  – Тангенс угла диэлектрических потерь;

 $S \approx 7.6 \; \text{дел}^2 - \Pi$ римерная площадь петли гистерезиса;

 $arepsilon_{max} pprox 10300 \; rac{{
m K}{
m J}^2}{{
m H}\cdot {
m M}^2} - {
m M}$ аксимальная диэлектрическая проницаемость;

 $\varepsilon(0)\approx 2000~\frac{\mbox{K}\mbox{\sc n}^2}{\mbox{H}\cdot\mbox{\sc m}^2}$  – Минимум диэлектрической проницаемости.

## 13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе эксперимента была изучена петля гистерезиса, изучены некоторые свойства сегнетоэлектриков, такие как поляризация под действием электрического поля и влияние потенциала поля на этот процесс: чем сильнее поле — тем сильнее смещение D, но зависимость не линейна как у проводников и диэлектриков.

#### Список использованных источников

- 1. Электромагнетизм. Основные законы / Иродов И.Е., ISBN 978-5-00101-498-0, Издательство "Лаборатория знаний10-е изд.
- 2. Методические указания по лабораторной работе 3.06
- 3. Савельев, И. В. Курс общей физики. В 5 т. Том 2. Электричество и магнетизм: учебное пособие для вузов / И. В. Савельев. 6-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 344 с. ISBN 978-5-8114-9248-0. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/189298">https://e.lanbook.com/book/189298</a>
- 4. Физика. Обработка экспериментальных данных: Учебно-методическое пособие: Для студ. 1,2 и 3-го курсов всех спец. и направлений очной и заочной форм обучения/ В.В. Курепин, И.В. Баранов. СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2012.- 56 с.